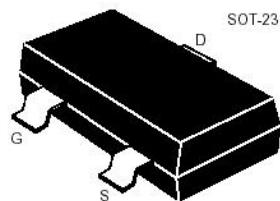




安徽富信半導體科技有限公司
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

BSS138

SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 溝道增強型 MOS 場效應管

■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rat 額定值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	50	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current (continuous) 漏極電流 - 連續	I_{DR}	220	mA
Drain Current (pulsed) 漏極電流 - 脉冲	I_{DRM}	880	mA

■THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	225 1.8	mW $\text{mW}/^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	350	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	150°C, -55 to +150°C	



安徽富信半導體科技有限公司
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

BSS138

■DEVICE MARKING 打標

BSS138=SS

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D=250\mu\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	50	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D=1\text{mA}$, $V_{GS}=V_{DS}$)	$V_{GS(\text{th})}$	0.8	—	1.6	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_{SD}=220\text{mA}$, $V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.4	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=\text{BV}_{DSS}$) ($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=0.6\text{BV}_{DSS}$)	I_{DSS}	—	—	0.5 100	uA nA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=\pm 20\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D=220\text{mA}$, $V_{GS}=10\text{V}$) ($I_D=220\text{mA}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$)	$R_{DS(\text{ON})}$	—	—	3.5 6	Ω
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=25\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	—	50	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=25\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	—	25	pF
Turn-ON Time 开啓時間 ($V_{DS}=30\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$, $R_{GEN}=25\Omega$)	$t_{(\text{on})}$	—	—	20	ns
Turn-OFF Time 短斷時間 ($V_{DS}=30\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$, $R_{GEN}=25\Omega$)	$t_{(\text{off})}$	—	—	20	ns

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in. 99.5%alumina.
- Pulse Width≤300 μs ; Duty Cycle≤2.0%.

BSS138

■ TYPICAL CHARACTERISTIC CURVE 典型特性曲线

